

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year)
31 March 2000 (31.03.00)

International application No.
PCT/JP99/04694

International filing date (day/month/year)
31 August 1999 (31.08.99)

in its capacity as elected Office

Applicant's or agent's file reference
HC146701

Priority date (day/month/year)
31 August 1999 (31.08.99)

31 August 1998 (31.08.98)

UCHIDA Takeshi et al

Applicant

1.	The designated Office is hereby notified of its election made: X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 23 February 2000 (23.02.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was was not was not made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 G neva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Maria Kirchner

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference HC146701	FOR FURTHER ACT	ION SeeNotifica Examinatio	tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)						
International application No. PCT/JP99/04694	International filing date of 31 August 1999		Priority date (day/month/year) 31 August 1998 (31.08.98)						
International Patent Classification (IPC) or r H01L 21/304	national classification and	PC							
Applicant HI	TACHI CHEMICAL	COMPANY, L	TD.						
and is transmitted to the applicant a	eccording to Article 36.		national Preliminary Examining Authority						
 This REPORT consists of a total of									
These annexes consist of a to	otal of site								
3. This report contains indications rela	ating to the following items	::							
I Basis of the report									
II Priority									
III Non-establishment	of opinion with regard to r	ovelty, inventive s	tep and industrial applicability						
IV Lack of unity of inv									
V Reasoned statement citations and explan	t under Article 35(2) with a nations supporting such sta	egard to novelty, i tement	nventive step or industrial applicability;						
VI Certain documents	cited								
VII Certain defects in the	he international application	i							
VIII Certain observation									
·									
Date of submission of the demand	I	Date of completion	of this report						
23 February 2000 (23.	.02.00)	17 N	ovember 2000 (17.11.2000)						
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer							
Facsimile No.		Telephone No.							

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/04694

	of the report	
1. With	regard to the elements of the international application:*	
\boxtimes	the international application as originally filed	
\sqcap	the description:	
	pages	, as originally filed
	pages	, filed with the demand
	pages, filed with the letter of	
	the claims:	
	pages	, as originally filed
	pages , as amended (together with any sta	atement under Article 19
	pages	-, filed with the demand
	pages, filed with the letter of	
	the drawings:	
لــا	pages	, as originally filed
	pages	_, filed with the demand
	pages, filed with the letter of	
\Box	the sequence listing part of the description:	
' لــا	pages	, as originally filed
	pages	, filed with the demand
	pages, filed with the letter of	
the in Thes	regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority international application was filed, unless otherwise indicated under this item. See elements were available or furnished to this Authority in the following language the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)) the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination or 55.3). In regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyon international application as filed has been furnished. The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the wribeen furnished.	which is: on (under Rule 55.2 and/ cation, the international
in th	The amendments have resulted in the cancellation of: the description, pages the claims. Nos the drawings, sheets/fig This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** lacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under his report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain 70.17).	Article 14 are referred to amendments (Rule 70.16
and		

INTERNATIONAL PREDMINARY EXAMINATION REPORT

mational application No. PCT/JP 99/04694

YES

NO

V.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting		inventive step or industrial app	licability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-22	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-22	YES
		Claims		NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-22	VEC

Claims

Claims

Citations and explanations 2.

Claims 1 to 10

Industrial applicability (IA)

The invention disclosed in Claims 1 to 10 involves an inventive step relative to the documents cited in the international search report. None of the documents discloses an abrasive liquid for metal containing two different types of protective film-forming agent, nor is this feature obvious to a person skilled in the art.

Claims 11 to 14

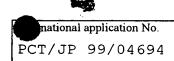
The invention disclosed in Claims 11 to 14 involves an inventive step relative to the documents cited in the international search report. None of the documents discloses an abrasive liquid for metal wherein the relationship between the chemi-mechanical abrasion speed and the etching speed is stipulated, as described in Claim 11, nor is this feature obvious to a person skilled in the art.

Claims 15 to 22

The invention disclosed in Claims 15 to 22 involves an inventive step relative to the documents cited in the international search report. None of the documents discloses an abrasive liquid for metal containing a first protective film-forming agent and a second protective

Í





film-forming agent which supplements the forming of the protective film of the first protective film-forming agent, nor is this feature obvious to a person skilled in the art.

			٠	-
				*

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

l					-	-							
╙	 		 	 			 			 		 	
Ι.		_		 			 	_	_				

VIII. Certain observations on the international application The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made: The conditions under which the chemi-mechanical abrasion speed and the etching speed are stipulated are unclear in the disclosures made in Claim 11.

			•

特許協力条約

REC'D 0 4 DEC 2000
WIPO PCT

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 HC146701	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。									
国際出願番号 PCT/JP99/04694	国際出願日 (日.月.年) 31.08.99	優先日 (日.月.年) 31.08.98								
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L21/304										
出願人(氏名又は名称) 日立化成工業株式会社										
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。										
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。 □ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。										
3. この国際予備審査報告は、次の内容										
I X 国際予備審査報告の基礎	<u> </u>									
Ⅱ □ 優先権										
Ⅲ 別 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性についての国際予備審査	監報告の不作成								
IV										
V X PCT35条(2)に規定 の文献及び説明	する新規性、進歩性又は産業上の利用可	能性についての見解、それを裏付けるため								
VI ある種の引用文献										
VII 国際出願の不備										
VII X 国際出願に対する意見										

国際予備審査の請求書を受理した日 23.02.00	国際予備審査報告を作成した日 17.11.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	3 P 8 9 1 6
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	鈴木 充	3 8 8 3 3 6 3

			, ai
_			
			,

Ι.	[3	国際予備審查報	景告の基礎				
1.	Į,	この国際予備署 S答するために PCT規則70.	提出され	下記の出願書類に た差し替え用紙は	基づいて作成さ、この報告書に	れた。 (法第6条(PC) おいて「出願時」とし、2	「14条)の規定に基づく命令に ▶報告書には添付しない。
	X	出願時の国際	除出願書類				
	П	明細書	第		ページ、	出願時に提出されたもの	מ
	u	明細書	第		ページ、 ページ、	国際予備審査の請求書る	
		明細書	第		ページ、 ページ、		· 付の書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲	第		項、	出願時に提出されたもの	
		請求の範囲	第	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	項、	PCT19条の規定に表	
		請求の範囲 請求の範囲	第 第		^{項、} 項、	国際予備審査の請求書る	付の書簡と共に提出されたもの
		6月 イベック単位区口	ж				, no a macovitation of
		図面	第			出願時に提出されたもの	7)
		図面	第		ページ/図、	国際予備審査の請求書る	
		図面	第		ページ/図、		付の書簡と共に提出されたもの
	\Box	明細書の配列	事の部分	笋	ページ、	出願時に提出されたもの	7)
	ш	明細書の配列			— ページ、	国際予備審査の請求書	
		明細書の配列		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ページ、		付の書簡と共に提出されたもの
2.		上記の出願書数	5の言語は	下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の言語である。	
	ا	上記の書類は、	下記の言	語である	語であ	る。	
	[国際調査	のために扱	是出された P C T st	規則23.1(b)にい	う翻訳文の言語	
	[DCT規	則48.3(b)	にいう国際公開の	言語		
	ſ	国際予備	審査のため	bに提出された P(CT規則55.2また	たは55.3にいう翻訳文の言	語
3.	,	一の国際出願に	ト マクレ	オチドVはアミノ	酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づ	き国際予備審査報告を行った。
Ο.	,						
	Į	_		れる書面による			
	Į			提出されたフレ			
	Į					是出された書面による配列	
	Į					是出されたフレキシブルデ	
	[_		詩面による配列表だ	が出願時における	る国際出願の開示の範囲を	·超える事項を含まない旨の陳述
	ſ	書の提出:		・記載1 を配列し、	フレキシブルデ	ノスカに トム配列表に記録	した配列が同一である旨の陳述
	L		があった。	- 60収した60分で	<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		COTCHE TO THE STATE OF THE STAT
4.	*	甫正により、↑	「記の書類	が削除された。			
		明細書	第		ページ		
		請求の範囲	第		項		
		図面	図面の第		~-	ジ/図	
5.		この国際予備 れるので、そ	請審査報告 の補正が	は、補充欄に示し されなかったもの	たように、補正)として作成した	が出願時における開示の	範囲を越えてされたものと認めら この補正を含む差し替え用紙は上

-		•
		¥
		,

国際予備審査報告

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について 文献及び説明	ての法第12条	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲 _	1 - 2 2		有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1 - 2 2		有 無
	産業上の利用可能性 (1 A)	請求の範囲 請求の範囲 _	1 – 2 2		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1-10

請求の範囲1-10に記載された発明は、国際調査報告で引用された各文献に対して進歩性を有する。各文献には異なる2種類の保護膜形成剤を含む金属用研磨液について記載されておらず、しかもその点は、当業者といえども容易に想到し得ないものである。

請求の範囲11-14

請求の範囲1-10に記載された発明は、国際調査報告で引用された各文献に対して進歩性を有する。各文献には、化学機械研磨速度とエッチング速度の関係について請求の範囲11に記載のように規定した金属用研磨液について記載されておらず、しかもその点は、当業者といえども容易に想到し得ないものである。

請求の範囲15-22

請求の範囲 15-22に記載された発明は、国際調査報告で引用された各文献に対して進歩性を有する。各文献には、第1の保護膜形成剤と、第1の保護膜形成剤が保護膜を形成するのを補助する第2の保護膜形成剤を含む金属用研磨液について記載されておらず、しかもその点は、当業者といえども容易に想到し得ないものである。

•		•
		¥

四际 广州 化 互	
VII. 国際出願に対する意見	
請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による	5十分な裏付についての意見 を次に 示す。
請求の範囲11の記載では、どのような条件 ング速度について規定してるのか不明確である	下における化学機械研磨速度、エッチ 。
,	

			ST



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04694

				
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁶ H01L21/304, 21/308, C23F1/	/16		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC		
B. FIELD:	S SEARCHED			
Minimum de	ocumentation searched (classification system followed C1 H01L21/304, 21/308, C23F1/	by classification symbols) 16		
Decuments	ion searched other than minimum documentation to the		in the Calabara	
Documentat	ion searched other idan minimum documenation to the	s extent that such documents are included	in the fields searched	
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)	
			·	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y	US, 5954997, A (CABOT CORP.),		1-22	
•	09 December, 1996 (09.12.96) & JP, 11-21546, A & EP, 8467 & WO, 98/26025, A1	42, A2	1.22	
Ą	JP, 8-83780, A (TOSHIBA CORPORA 26 March, 1996 (26.03.96), Claims & US, 5770095, A	ATION),	. 1-22	
A	JP, 7-233485, A (TOSHIBA CORPOR 05 September, 1995 (05.09.95), Claims (Family: none)	RATION),	1-22	
A	JP, 9-55363, A (TOSHIBA CORPORE 25 February, 1997 (25.02.97), Claims (Family: none)	ATION),	1-22	
A	JP, 9-184081, A (Nippon Peroxic 15 July, 1997 (15.07.97), Claims (Family: none)	ie Co., Ltd.),	1-22	
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive attention cannot be considered to involve an inventive step when the document is caken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of part				
22 N	nerval completion of the international search OVember, 1999 (22.11.99)	Date of mailing of the international sear 07 December, 1999 (0	ch report 07.12.99)	
	ailing address of the ISA nese Patent Office	Authorized officer	***************************************	
Facsimile No	o.	Telephone No.		

			•	
		,		
				,

世界知的所有権機関 際 事 務

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H01L 21/304, 21/308, C23F 1/16 (11) 国際公開番号

WO00/13217

(43) 国際公開日

2000年3月9日(09.03.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/04694

(22) 国際出願日

1999年8月31日(31.08.99)

(30) 優先権データ

特願平10/245616 特願平10/351188

1998年8月31日(31.08.98)

1998年12月10日(10.12.98)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

日立化成工業株式会社

(HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.)[JP/JP]

〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo, (JP)

株式会社 日立製作所(HITACHI, LTD.)[JP/JP]

〒100-8220 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

内田 剛(UCHIDA, Takeshi)[JP/JP] .-

星野鉄哉(HOSHINO, Tetsuya)[JP/JP] --

上方康雄(KAMIGATA, Yasuo)[JP/JP] -

寺崎裕樹(TERAZAKI: Hiroki)[JP/JP]

〒305-4247 茨城県つくば市和台48番

日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki, (JP)

IP

A1

〒317-8555 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki, (JP) 本間喜夫(HONMA, Yoshio)[JP/JP] 近藤誠一(KONDOH, Seiichi)[JP/JP] 〒185-0014 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社 日立製作所 中央研究所内 Tokyo, (JP) (74) 代理人

松沢 純(MATSUZAWA, Jun)[JP/JP] .-

弁理士 富田和子,外(TOMITA, Kazuko et al.) 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9-10 横浜HSビル7階 Kanagawa, (JP)

(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM. TR. TT. UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI

特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ユ

ーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

国際調査報告書

ABRASIVE LIQUID FOR METAL AND METHOD FOR POLISHING (54) Title:

(54)発明の名称 金属用研磨液及び研磨方法

(57) Abstract

An abrasive liquid for a metal comprising (1) an oxidizing agent for a metal, (2) a dissolving agent for an oxidized metal, (3) a first protecting film-forming agent such as an amino acid or an azole which adsorbs physically on the surface of the metal and/or forms a chemical bond, to thereby form a protecting film, (4) a second protecting film-forming agent such as polyacrylic acid, polyamido acid or a salt thereof which assists the first protecting film-forming agent in forming a protecting film and (5) water; and a method for polishing.

本発明では、(1)金属の酸化剤と、(2)酸化金属溶解剤と、(3)アミノ酸やアゾール類といった、金属膜表面に物理的吸着及び/又は化学的結合を形成することにより保護膜を形成する第1の保護膜形成剤と、(4)ポリアクリル酸、ポリアミド酸又はその塩といった、第1の保護膜形成剤が保護膜を形成するのを補助する第2の保護膜形成剤と、(5)水とを含有する金属用研磨液及び研磨方法が提供される。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

DEEFFGGGGGGGGGHHIIIIIJKKKK MESIRABDEHMNWRRUDELNSTPEGPR ドエスフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイ日ケキ北韓 ドエスフフガ英ググガガギギギクハイアイスンイタ本ニル朝国 アンテンアガドルラドスリ アギ鮮 アンテンアガドルラドスリ アギ鮮 アンテンアガドルラドスリ アギ鮮 アンテンアガドルラドスリ アギ鮮 アンテンアガドルラドスリ アギ鮮

RSSSSSSSSTTTTTTTUUUUVYZZ RSSSSSSSSSTTTTTTTTUUUVYZZ UDEGIKLNZDGJZMRTAGSZNUA デーニキレン・タアニッナースナスカエデーニキレン・タアニッケーダイダーキーリブ デーニキレン・メライダーキーリブ デーニキレン・タアニッナースナスカエデーニーング タアニッナースナスカエーリブ ターウンススシススシセスチトタタトトトウウ米ウヴュ南ジ アンススシススシセスチトタタトトトウウ米ウヴュ南ジ アンススシススシーステム・ファン アンコースカエーリブエーアン アンコースカエーアン アンコースカーアン アンコ

1

明細書

金属用研磨液及び研磨方法

技術分野

本発明は、特に半導体装置の配線形成工程における研磨に使用するのに適した金属用研磨液及び研磨方法に関する。

背景技術

近年、半導体集積回路(以下、LSIと記す)の高集積化、 高性能化に伴って新たな微細加工技術が開発されている。化学 機械研磨(以下、CMPと記す)法もその一つであり、LSI 製造工程、特に多層配線形成工程における層間絶縁膜の平坦化、 金属プラグ形成、埋め込み配線形成において頻繁に利用される 技術である。この技術は、例えば米国特許第4944836号 公報に開示されている。

また、最近はLSIを高性能化するために、配線材料として 銅合金の利用が試みられている。しかし、銅合金は従来のアル ミニウム合金配線の形成で頻繁に用いられたドライエッチング 法による微細加工が困難である。そこで、あらかじめ溝を形成 してある絶縁膜上に銅合金薄膜を堆積して埋め込み、溝部以外 の銅合金薄膜をCMPにより除去して埋め込み配線を形成する、

3.7

いわゆるダマシン法が主に採用されている。この技術は、例えば特開平2-278822号公報に開示されている。

金属のCMPの一般的な方法は、円形の研磨定盤(プラテン) 上に研磨パッドを貼り付け、研磨パッド表面を金属用研磨液で 浸し、基体の金属膜を形成した面を押し付けて、その裏面から 所定の圧力(以下、研磨圧力と記す)を加えた状態で研磨定盤 を回し、研磨液と金属膜の凸部との機械的摩擦によって凸部の 金属膜を除去するものである。

CMPに用いられる金属用研磨液は、一般には酸化剤及び固体砥粒からなっており必要に応じてさらに酸化金属溶解剤、保護膜形成剤が添加される。まず酸化によって金属膜表面を酸化し、その酸化層を固体砥粒によって削り取るのが基本的なメカニズムと考えられている。凹部の金属表面の酸化層は研磨が入った。まり触れず、固体砥粒による削り取りの効果が及ばないので、CMPの進行とともに凸部の金属層が除去されて基本を面は平坦化される。この詳細についてはジャーナル・オブ・ロケミカルソサエティ誌の第138巻11号(1991年発行)の3460~3464頁に開示されている。

固体砥粒によって削り取られた金属酸化物の粒を、酸化金属溶解剤により研磨液に溶解させてしまえば、固体砥粒による削り取りの効果が増すと考えられる。ただし、凹部の金属膜表面の酸化層も溶解(以下エッチングと記す)されて金属膜表面がさらに酸化されると、酸化剤によって金属膜表面がさらに酸化されていまれが繰り返されると凹部の金属膜のエッチングが進行してよれが繰り返されると凹部の金属膜のエッチングが進行してよい、平坦化効果が損なわれることが懸念される。これを防ぐためにさらに保護膜形成剤が添加される。酸化金属溶解剤と保護

膜形成剤の効果のバランスを取ることが重要であり、金属膜表面の酸化層はあまりエッチングされず、削り取られた酸化層の 粒が効率良く溶解され、CMPによる研磨速度が大きいことが 望ましい。

この様に酸化金属溶解剤と保護膜形成剤を添加して化学反応の効果を加えることにより、CMP速度(すなわちCMPによる研磨速度)が向上するとともに、CMPされる金属層表面の損傷(ダメージ)も低減される効果が得られる。

しかしながら、従来の固体砥粒を含む金属用研磨液を用いて CMPによる埋め込み配線形成を行う場合には、(1)埋め込まれた金属配線の表面中央部分が等方的に腐食されて皿の様に 窪む現象(以下ディッシングと記す)の発生、(2)固体砥粒 に由来する研磨傷(スクラッチ)の発生、(3)研磨後の基体 表面に残留する固体砥粒を除去するための洗浄プロセスが複雑 であること、(4)固体砥粒そのものの原価や廃液処理に起因 するコストアップ、等の問題が生じる。

ディッシングや研磨中の銅合金の腐食を抑制し、信頼性の高いLSI配線を形成するために、グリシン等のアミノ酢酸又はアミド硫酸からなる酸化金属溶解剤及びベンゾトリアゾール(以下、BTAと記す)を含有する金属用研磨液を用いる方法が提唱されている。この技術は、例えば特開平8-83780号公報に記載されている。

しかし、BTAの保護膜形成効果は非常に高いため、エッチング速度のみならず研磨速度をも顕著に低下させてしまう。従って、エッチング速度を十分に低下させ、かつCMP速度を低下させないような保護膜形成剤を金属用研磨液に用いることが

4

望まれている。

発明の開示

本発明は、エッチング速度を十分に低下させ、高いCMP速度を維持しつつ、信頼性の高い金属膜の埋め込みパターンを形成することのできる金属用研磨液及び研磨方法を提供するものである。

本発明の金属用研磨液は、金属を酸化するための酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第1の保護膜形成剤とは 異なる第2の保護膜形成剤及び水を含有する。

保護膜形成剤は金属表面に保護膜を形成するものである。

第1の保護膜形成剤としては、アンモニア、アルキルアミン、アミノ酸、イミン、アゾール等の含窒素化合物及びその塩、及びメルカプタン、グルコース及びセルロースから選ばれた少なくとも一種が好ましい。これら第1の保護膜形成剤は、金属膜表面に物理的吸着及び/又は化学的結合を形成することにより保護膜を形成する化合物である。

第2の保護膜形成剤としては、アルコール(すなわちアルコール性水酸基を有する化合物)、フェノール類(すなわちフェノール性水酸基を有する化合物)、エステル、エーテル、多糖類、アミノ酸塩、ポリカルボン酸及びその塩、ビニル系ポリマ、スルホン酸及びその塩、芳香族アミン、アミド、アゾ化合物並びにモリブデン化合物から選ばれた少なくとも一種が好ましい。これら第2の保護膜形成剤は、第1の保護膜形成剤が保護膜を

形成するのを補助する化合物である。

酸化剤としては、過酸化水素、硝酸、過ヨウ素酸カリウム、 次亜塩素酸及びオゾン水から選ばれた少なくとも一種が好まし い。

酸化金属溶解剤としては、有機酸、そのアンモニウム塩及び 硫酸から選ばれた少なくとも一種が好ましい。

本発明では、保護膜形成剤のうちの第2の保護膜形成剤を含ませずに10nm/分以下のエッチング速度に抑制する効果を発現するに必要な第1の保護膜形成剤の添加濃度Aに対し、第2の保護膜形成剤を添加することによって前記濃度Aよりも低濃度の第1の保護膜形成剤を含有させて10nm/分以下のエッチング速度に抑制する効果を発現可能にした金属用研磨液が提供される。すなわち、この場合、第2の保護膜形成剤は、エッチング速度を10nm/分以下に抑制するのに必要な第1の保護膜形成剤の添加量を減少させる化合物である。

本発明の研磨方法は、上述した本発明の金属用研磨液中で被研磨物表面の金属膜を研磨することにより除去する研磨方法である。除去対象の金属膜には、銅、銅合金、銅酸化物、銅合金酸化物などが適している。そこで、本発明では、上述の金属用研磨液を用いて、銅、銅合金、銅酸化物及び銅合金酸化物のうちから選ばれた少なくとも1種の金属層を含む積層膜からなる金属膜を研磨する工程によって少なくとも金属膜の一部を除去する研磨方法が提供される。

本発明では性質の異なる第1及び第2の保護膜形成剤を組み合わせることにより、CMP速度は維持しつつ、エッチング速度を十分に低下させた研磨液とそれを用いた研磨方法を提供す

る。第1の保護膜形成剤は銅とキレート錯体を生じやすいもの、例えばエチレンジアミンテトラ酢酸、ベンゾトリアゾール等を用いる。これらの金属表面保護膜形成効果は極めて強く、例えば金属用研磨液中に0.5重量%以上を含ませると、銅合金膜はエッチングはおろかCMPすらされなくなる。

これに対して本発明者らは、第1の保護膜形成剤とは異なる第2の保護膜形成剤を併用することにより、第1の保護膜形成剤の添加濃度が低くとも十分に低いエッチング速度に抑制できることを見出した。しかもこの様な研磨液を用いた場合は、エッチング速度は低下してもCMP速度はあまり低下しないという好ましい特性が得られることが分かった。加えて第1の保護膜形成剤と第2の保護膜形成剤とを併用することにより、研磨液に固体砥粒を含ませなくとも実用的なCMP速度での研磨が可能になることを見出した。これは従来の固体砥粒の摩擦による削り取りの効果に対して研磨パッドの摩擦による削り取りが発現されたためと考えられる。

抑制すべきエッチング速度の値としては10nm/分以下に抑制できれば好ましい平坦化効果が得られることが分かった。 C M P 速度の低下が許容できる範囲であればエッチング速度はさらに低い方が望ましく、5nm/分以下に抑制できれば例えば50%程度の過剰C M P (金属膜を C M P 除去するに必要な時間の1.5倍の C M P を行うこと)を行ってもディッシングは問題とならない。

なお、本明細書におけるエッチング速度は、研磨液中に被研

磨物を浸し、研磨液を液温 2 5 ℃、攪拌速度 1 0 0 r p m で攪拌したときの、被研磨物表面の金属膜(スパッタリングにより形成された銅膜)がエッチングされる速度であり、浸漬前後の金属膜厚差を電気抵抗値から換算して求め、これを浸漬時間で割って求めた速度である。

また、CMP速度(すなわち化学機械研磨速度)は、研磨圧 カ210g/сm²、被研磨物と研磨定盤との相対速度36m /分、液温25℃の条件で、被研磨物表面の金属膜(スパッタ リングにより形成された銅膜)を研磨し、研磨前後の金属膜厚 差を電気抵抗値から換算して求め、これを処理時間で割って求 めた速度である。

本発明によれば、第1の保護膜形成剤のみを用いた研磨液とは異なり、固体砥粒による強い機械的摩擦に頼らなくとも、それよりもはるかに柔らかい研磨パッドとの摩擦によってCMP 平坦化を実現することができる。

さらに、本発明では、本発明の金属用研磨液を用いて、表面に凹部を有する基体上に銅、銅合金(銅/クロム等)などを含む金属膜を形成・充填した基体を研磨する研磨方法が提供される。このような基体を本発明の研磨液を用いてCMPすると、基体の凸部の金属膜が選択的にCMPされ、凹部に金属膜が残されて所望の導体パターンが得られる。本発明の研磨液では、実質的に固体砥粒を含まなくともよく、固体砥粒よりもはるかに機械的に柔らかい研磨パッドとの摩擦によってCMPが進むために研磨傷は劇的に低減される。

本発明の金属用研磨液は、酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第2の保護膜形成剤及び水を必須成分とする。

固体砥粒は実質的に含まれなくともよいが、使用することもで きる。

つぎに、本発明の金属用研磨液に含まれる各成分の具体例について説明する。

金属の酸化剤としては、過酸化水素(H₂O₂)、硝酸、過ヨウ素酸カリウム、次亜塩素酸、オゾン水等が挙げられる。基体が集積回路用素子を含むシリコン基板である場合、アルカリ金属、アルカリ土類金属、ハロゲン化物などによる汚染は望ましくないので、不揮発成分を含まない酸化剤が望ましいが、オゾン水は組成の時間変化が激しいことから、上に挙げた酸化剤のうち、過酸化水素が最も好ましい。ただし、適用対象の基体が半導体素子を含まないガラス基板などである場合は、不揮発成分を含む酸化剤であっても差し支えない。

酸化金属溶解剤は、水溶性のものが望ましい。水溶性酸化金属溶解剤には、

ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、2ーメチル酪酸、 nーヘキサン酸、3,3ージメチル酪酸、2ーエチル酪酸、4 ーメチルペンタン酸、nーヘプタン酸、2ーメチルヘキサン酸、 nーオクタン酸、2ーエチルヘキサン酸、安息香酸、グリコール酸、サリチル酸、グリセリン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、マレイン酸、フタル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸等の有機酸、

これら有機酸のアンモニウム塩や、過硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、塩化アンモニウム等のアンモニウム塩類、

硫酸、クロム酸等の無機酸、及び、アンモニア錯体などが挙 げられる。これらは単独で用いてもよく、いずれかを組み合わ せて用いてもよい。

銅、銅合金、銅酸化物及び/又は銅合金酸化物からなる金属層を含む積層膜に対しては、これらのうち、ギ酸、マロン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸が好適である。これらは後述の第1及び第2の保護膜形成剤とのバランスが得やすい点で好ましい。特に、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸については実用的なCMP速度を維持しつつ、エッチング速度を効果的に抑制できるという点で好ましい。

第1の保護膜形成剤としては、

アンモニア;

ジメチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、プロピレンジアミン等のアルキルアミンや、エチレンジアミン四 酢酸(以下、EDTAと略す)、ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム及びキトサン等のアミン;

がリシン、L-Pラニン、 $\beta-P$ ラニン、L-2-Pミノル部 酸、L-Jルバリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリコン、L-Jリコン、L-Jリコン、L-Jリコン、L-Jリコン、L-Jリコシン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリコニー L-Jリン、L-Jリコニー L-Jリン、L-Jリン、L-Jリン、L-Jリコニー L-Jリン・L-Jリン・L-Jリコニー L-Jリン・L-J

スパラギン、L-グルタミン、アザセリン、L-アルギニン、L-カナバニン、L-シトルリン、 $\delta-ヒドロキシ-L-リシン$ 、クレアチン、L-キヌレニン、L-ヒスチジン、1-メチル-L-ヒスチジン、xu エルゴチオネイン、xu エートリプトファン、アクチノマイシンxu アンギオテンシンxu 及びアンチパイン等のアミノ酸;

ジチゾン、クプロイン(2, 2, -ビキノリン)、ネオクプロイン(2, 9-ジメチル-1, 10-フェナントロリン)、バソクプロイン(2, 9-ジメチル-4, 7-ジフェニル-1, <math>10-フェナントロリン)及びキュペラゾン(ビスシクロヘキサノンオキサリルヒドラゾン)等のイミン;

ベンズイミダゾールー2ーチオール、2ー [2ー (ベンゾチアゾリル)] チオプロピオン酸、2ー [2ー (ベンゾチアゾリル)] チオプチル酸、2ーメルカプトベンゾチアゾール)、1,2,3ートリアゾール、1,2,4ートリアゾール、3ーアミノー1H-1,2,4ートリアゾール、ベンゾトリアゾール、1ーヒドロキシベンゾトリアゾール、1ージヒドロキシプロピルベンゾトリアゾール、2,3ージカルボキシプロピルベンゾトリアゾール、4ーエシブトリアゾール、4ーカルボーシルー1H-ベンゾトリアゾール、4ーオクチルオキシカルボニルー1H-ベンゾトリアゾール、4ーオクチルオキシカルボニルー1H-ベンゾトリアゾール、5ーヘキシルベンゾトリアゾール、Nー(1,2,3-ベンゾトリアゾリルー1-メチル)-2ーエチルヘキ

シルアミン、トリルトリアゾール、ナフトトリアゾール、ビス [(1-ベンゾトリアゾリル)メチル]ホスホン酸等のアゾール;

ノニルメルカプタン、ドデシルメルカプタン、トリアジンチ オール、トリアジンジチオール、トリアジントリチオール等の メルカプタン;及び、

グルコース、セルロース等の糖類が挙げられる。これらは単 独で用いてもよく、適宜組み合わせて用いてもよい。

これらの中でも、キトサン、エチレンジアミン四酢酸、Lートリプトファン、キュペラゾン、トリアジンジチオール、ベンゾトリアゾール、4-ヒドロキシベンゾトリアゾール、4-カルボキシル-1*H*-ベンゾトリアゾールが、高いCMP速度と低いエッチング速度を両立する上で好ましい。特に、ベンゾトリアゾール及びその誘導体が好適である。ベンゾトリアゾール誘導体には、上述したアゾールなどが挙げられる。

第2の保護膜形成剤としては、

 $1 - \mathcal{J} \Box \mathcal{N} \mathcal{J} - \mathcal{N}$ 、 $2 - \mathcal{J} \Box \mathcal{N} \mathcal{J} - \mathcal{N}$ 、 $2 - \mathcal{J} \Box \mathcal{U} \mathcal{V} - 1 - \mathcal{J}$ $\mathbf{J} - \mathcal{N}$ 、 $\mathbf{J} - \mathcal{N}$

ロヘキサノール、DL-3-ヘキシルアルコール、1-ヘプタ ノール、2 - エチルヘキシルアルコール、(S) - (+) - 2 ーオクタノール、1ーオクタノール、DL-3ーオクチルアル コール、2-ヒドロキシベンジルアルコール、2-ニトロベン ジルアルコール、3,5-ジヒドロキシベンジルアルコール、 3. 5 - ジニトロベンジルアルコール、3 - フルオロベンジル アルコール、3-ヒドロキシベンジルアルコール、4-フルオ ロベンジルアルコール、4-ヒドロキシベンジルアルコール、 ベンジルアルコール、m- (トリフルオロメチル) ベンジルア ルコール、m-アミノベンジルアルコール、m-ニトロベンジ ルアルコール、 o - アミノベンジルアルコール、 o - ヒドロキ シベンジルアルコール、p-ヒドロキシベンジルアルコール、 p-ニトロベンジルアルコール、2-(p-フルオロフェニル) エタノール、2-アミノフェネチルアルコール、2-メトキシ ベンジルアルコール、2-メチル-3-ニトロベンジルアルコ ール、2-メチルベンジルアルコール、2-ニトロフェネチル アルコール、2-フェニルエタノール、3,4-ジメチルベン ジルアルコール、3 - メチル-2-ニトロベンジルアルコール、 3-メチル-4-ニトロベンジルアルコール、3-メチルベン ジルアルコール、4-フルオロフェネチルアルコール、4-ヒ ドロキシー3-メトキシベンジルアルコール、4-メトキシベ ンジルアルコール、4-メチル-3-ニトロベンジルアルコー ル、5-メチル-2-ニトロベンジルアルコール、 $DL-\alpha-$ ヒドロキシエチルベンゼン、o-(トリフルオロメチル)ベン ジルアルコール、p-(トリフルオロメチル)ベンジルアルコ ール、p-アミノフェネチルアルコール、p-ヒドロキシフェ

ニルエタノール、p-メチルベンジルアルコール及びS-フェネチルアルコール等のアルコール;

4-メチルフェノール、4-エチルフェノール及び4-プロ ピルフェノール等のフェノール;

グリセリンエステル、ソルビタンエステル、メトキシ酢酸、 エトキシ酢酸、3-エトキシプロピオン酸及びアラニンエチル エステル等のエステル:

ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール、ポリエチレングリコールアルケニルエーテル、アルキルポリエチレングリコール、アルキルポリエチレングリコール、アルキルポリエチレングリコール、アルキルポリエチレングリコール、アルケニルポリエチレングリコールでルカールポリエチレングリコールアルケニルポリエーテル、アルケニルポリコールでリコールアルケニルがリコールアルケニルボリプロピレングリコールアルポリプロピレングリコールアルポリプロピレングリコールアルポリプロピレングリコールアルポリプロピレングリコールアルキルポリプロピレングリコールアルキルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルポリプロピレングリコールアルケニルエーテル等のエーテル:

アルギン酸、ペクチン酸、カルボキシメチルセルロース、カ ードラン及びプルラン等の多糖類;

グリシンアンモニウム塩及びグリシンナトリウム塩等のアミノ酸塩;

ポリアスパラギン酸、ポリグルタミン酸、ポリリシン、ポリリンゴ酸、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸アンモニウム塩、ポリメタクリル酸ナトリウム塩、ポリアミド酸、ポリマレイン酸、ポリイタコン酸、ポリフマル酸、ポリアクリルアミド、アクリル酸アンモニウム塩、ポリアクリル酸ナトリウム塩、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸、ポリアミド酸アンモニウム塩、ポリアミド酸ナトリウム塩及びポリグリオキシル酸等のポリカルボン酸及びその塩;

ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン及びポリアクロレイン等のビニル系ポリマ;

メチルタウリン酸アンモニウム塩、水チルタウリン酸ナトリウム塩、硫酸メチルナトリウム塩、硫酸エチルアンモニウム塩、ビニルスルホン酸ナトリウム塩、1ーアリルスルホン酸ナトリウム塩、2ーアリルスルホン酸ナトリウム塩、ストキシメチルスルホン酸ナトリウム塩、3ーエトキシプトリウム塩、メトキシメチルスルホン酸アンモニウム塩、3ーエトキシプトリウム塩、メトキシメチルスルホン酸アンモニウム塩、3ーエトキシプトリウム塩、スルホン酸アンモニウム塩、3ーエトキシメチルスルホン酸アンモニウム塩、3ーエトキシメチルスルホン酸アンモニウム塩、3ーエトキシメチルスルホン酸アンモニウム塩、7ーピルスルホン酸アンスルホン酸アンスルホン酸アンスルボンウム塩、アニリンスルボンジルアミド、アクリルアミド、アクリルアミド、ピリジンー4ーカルボキアミド、アミド、フェニル酢酸アミド、ピリジンー4ーカルボキリンルアミド等のアミド:

1、1、一アゾビス(シクロヘキサン-1ーカルボニトリル)、
1、1、一アゾビス(1ーアセトキシ-1ーフェニルエタン)、
2、2、一アゾビス(2、4ージメチルバレロニトリル)、2、
2、一アゾビス(4ーメトキシー2、4ージメチルバレロニトリル)、2、2、一アゾビス(イソブチロニトリル)、2ー[2ー(3、5ージプロモピリジル)アゾ]ー5ージメチルアミノ安息香酸、4、4、一アゾビス(4ーシアノ吉草酸)、4、4、一アゾキシアニソール、アゾキシメタン、アゾベンゼン、アゾキシベンゼン、アゾジカルボン酸ジ(ナーブチル)、フェナジン、マラカイトグリーン、メチルオレンジ、コンゴーレッド及びクリスタルバイオレット等のアゾ化合物;並びに、

モリブデン (VI) 酸ニナトリウムニ水和物及び七モリブデン (VI) 酸六アンモニウム四水和物等のモリブデン化合物等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、適宜組み合わせて用いてもよい。

適用する基体が半導体集積回路用シリコン基板などの場合は、 アルカリ金属、アルカリ土類金属、ハロゲン化物等による汚染 は望ましくないため、酸又はそのアンモニウム塩が望ましい。 ただし、基体がガラス基板等である場合はその限りではない。

これらのうち、2 - メチル-3 - 二トロベンジルアルコール、ポリプロピレングリコール、ポリアスパラギン酸、ポリリンゴ酸、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸アンモニウム、ポリメタクリル酸アンモニウム、ポリアミド酸、ポリアミド酸アンモニウム、ポリアクリルアミド、メチルタウリ

ン酸ナトリウム、ベンジルアミン、ニコチンアミド、スルファニルアミド、コンゴーレッド、七モリブデン(VI)酸六アンモニウム四水和物が、高いCMP速度と低いエッチング速度を両立する上で好ましく、とりわけ、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアミド酸、ポリアクリル酸アンモニウム、ポリメタクリル酸アンモニウム、ポリアミド酸アンモニウム及びポリアクリルアミドが好ましい。

本発明を適用する金属膜としては、銅、銅合金、銅酸化物及び銅合金酸化物(以下、これらを合わせて銅合金という)から選ばれた少なくとも1種を含む積層膜である。

また、本発明では、CMP速度が100nm/分以上、エッチング速度が10nm/分以下である金属用研磨液が提供される。このような特性を有する研磨液は、本発明により始めて実現されたものであり、金属の酸化剤、酸化金属溶解剤及び水を含み、さらに、第1の保護膜形成剤と、当該第1の保護膜形成剤とは異なる第2の保護膜形成剤とを組み合わせて配合することにより、達成することができる。

つぎに、用いることのできる第1の保護膜形成剤と第2の保護膜形成剤との組合せを第1の保護膜形成剤/第2の保護膜形成剤として示す。なお、これらの組合せは単なる例示であり、本発明はこれらに限定されるものではない。必要に応じて、適宜他の組合せを用いてもよい。

CMP速度が100nm/分以上、エッチング速度が10nm/分以下となる組合せとしては、例えば、キュペラゾン/ポリリンゴ酸、キュペラゾン/ポリアスパラギン酸、キュペラゾン/ポリアクリルアミド、L-トリプトファン/ポリアクリル

アミド、Lートリプトファン/ポリアクリル酸アンモニウム、 Lートリプトファン/ポリリンゴ酸、ベンゾトリアゾール/ポ リアクリルアミド、ベンゾトリアゾール/ポリアクリル酸アン モニウム、ナフトトリアゾール/ポリリンゴ酸、ナフトトリア ゾール/2ーメチルー3ーニトロベンジルアルコール、トリア ジンジチオール/ポリアスパラギン酸、トリアジンジチオール /ポリアクリルアミドなどが挙げられる。

また、CMP速度が100nm/分以上、エッチング速度が1nm/分以下になる組合せとしては、キュペラゾン/ポリアクリルアミド、Lートリプトファン/ポリアクリルアミド、Lートリプトファン/ポリアクリルアミド、ベンゾトリアゾール/ポリアクリルアミド、ベンゾトリアゾール/ポリアクリル酸アンモニウム、ナフトトリアゾール/ポリリンゴ酸、トリアジンジチオール/ポリアクリルアミドなどが挙げられる。

CMP速度が250nm/分以上、エッチング速度が10nm/分以下となる組合せとしては、キュペラゾン/ポリリンゴ酸などが挙げられる。

つぎに、各成分の配合量について説明する。

酸化剤成分の配合量は、酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第2の保護膜形成剤及び水の総量100gに対して、0.03mol~0.7molとすることが好ましく、0.03mol~0.5molとすることがより好ましく、0.2mol~0.3molとすることが特に好ましい。この配合量が0.003mol未満では、金属の酸化が不十分でСМР速度が低く、0.7molを超えると、研磨面に荒れが生じる

傾向がある。

本発明における酸化金属溶解剤成分の配合量は、酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第2の保護膜形成剤及び水の総量100gに対して、0~0.005molとすることが好ましく、0.0005mol~0.0015molとすることがより好ましく、0.0005mol~0.0015molとすることが特に好ましい。この配合量が0.005mol~1と超えると、エッチングの抑制が困難となる傾向がある。

第1の保護膜形成剤の配合量は、酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第2の保護膜形成剤及び水の総量100gに対して0.0001mo1~0.05mo1とすることが好ましく0.0003mo1~0.0035mo1とすることがより好ましく、0.0005mo1~0.0035mo1とすることが特に好ましい。この配合量が0.0001mo1未満では、エッチングの抑制が困難となる傾向があり、0.05mo1を超えるとСMP速度が低くなってしまう傾向がある。

第2の保護膜形成剤の配合量は、酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第2の保護膜形成剤及び水の総量100gに対して0.001~0.3重量%とすることが好ましく0.03重量%~0.1重量%とすることがより好ましく0.01重量%~0.08重量%とすることが特に好ましい。この配合量が0.001重量%未満では、エッチング抑制において第1の保護膜形成剤との併用効果が現れない傾向があり0.3重量%を超えるとCMP速度が低下してしまう傾向がある。

本発明の研磨液及び研磨方法における効果発現の作用機序は明らかではないが、第1及び第2の保護膜形成剤を併用したこ

とにより、エッチングは抑制するものの、研磨パッドによる摩擦に対しては金属表面保護膜として機能せずにCMPが進行するものと推定される。

一般に、CMPにおいては研磨傷の発生の度合いは固体砥粒の粒径や粒径分布や形状に依存し、絶縁膜の削れによる膜厚減少(以下、エロージョンと記す)や平坦化効果の劣化は、やはり固体砥粒の粒径や研磨パッドの物理的性質に依存し、金属膜、特に銅膜表面をBTAで処理した場合、金属膜のディッシングは研磨パッドの硬さや研磨液の化学的性質に依存すると考えられる。すなわち、硬い固体砥粒はCMPの進行には必要ではあるが、CMPにおける平坦化効果やCMP面の完全性(研磨傷等の損傷がないこと)を向上させるためには望ましくない。平坦化効果は実際には固体砥粒よりも柔らかい研磨パッドの特性に依存していることが分かる。

このことより、本発明は、固体砥粒がなくともCMPを進行させることができるという点で、銅合金のCMP、引いてはそれを用いた埋め込みパターンの形成に極めて望ましいと考えられる。

なお、第1の保護膜形成剤は、金属表面に強固な保護膜を形成する作用を備える。例えば、BTAを含む液に銅合金膜表面をさらすと、銅(Cu)もしくはその酸化物とBTAとの反応により、Cu(I)BTA又はCu(II)BTAの構造を主骨格とするポリマ状錯化合物皮膜が形成されると考えられる。この皮膜はかなり強固で、BTA0.5重量%を含む金属用研磨液を用いた場合、当該研磨液に固体砥粒が含まれていたとしても、一般にはほとんど研磨されない。

一方、第1の保護膜形成剤を用いず、第2の保護膜形成剤の みを単独で用いて金属用研磨液を調製した場合、特にエッチン グ速度の抑制が困難となり、保護効果が十分でない。

この様に第1の保護膜形成剤と第2の保護膜形成剤とは、その作用が異なっており、保護膜形成剤の種類に応じて異なる種類の保護膜が形成される。本発明は、上述の第1及び第2の保護膜形成剤を組み合わせて用いることにより、エッチング速度の抑制とCMP速度維持とを両立でき、しかも固体砥粒による強い摩擦をも不要になるという新たな知見に基づくものである。

発明を実施するための最良の形態

以下、実施例により本発明を説明する。本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。

実施例1~12、比較例1~5

《研磨液調製方法》

WO 00/13217

DLーリンゴ酸(試薬特級) 0. 15重量部に水 70重量部を加えて溶解し、これに第1の保護膜形成剤 0. 2重量部をメタノール 0. 8重量部に溶解させた溶液を加えた後、さらに第2の保護膜形成剤 0. 05重量部を加え、最後に過酸化水素水(試薬特級、30%水溶液)33.2重量部を加えて金属用研磨液を得た。なお、各実施例及び比較例において用いた保護膜形成剤を、表1に示す。

次に、得られた研磨液を用いて、被研磨物を研磨した。研磨 条件等はつぎの通りである。

《研磨条件》

被研磨基板:厚さ1μmの銅膜を形成したシリコン基板

研磨パッド: IC1000 (ロデール社製)

研磨圧力: 2 1 0 g/cm²

基体と研磨定盤との相対速度:36m/分

《研磨品評価項目》

CMP速度:銅膜のCMP前後での膜厚差を電気抵抗値から換算して求め、処理時間で割って求めた。処理時間は1分とした。

エッチング速度:上述の被研磨基板と同様の基板を別途用意し、室温(25℃)で攪拌(攪拌速度100rpm)しながら研磨液に浸漬させて、浸漬前後の銅層膜厚差を電気抵抗値から換算し、浸漬時間で割って求めた。浸漬時間は10分とした。

また、実際のCMP特性を評価するため、絶縁層中に深さ 0.5 μmの溝を形成して公知のスパッタ法によって銅膜を形成して公知の熱処理によって埋め込んだシリコン基板についても基体として用いてCMPを行った。CMP後の基体の目視、光学顕微鏡観察、及び電子顕微鏡観察によりエロージョン及び研磨傷発生の有無を確認した。その結果、エロージョン及び研磨傷の発生は見られなかった。実施例 1~11及び比較例 1~5における、CMP速度及びエッチング速度の評価結果を表1に示す。

表1

WO 00/13217

·				
	第1の保護膜形成剤	第2の保護膜形成剤	CPS速度	エッチング速度
実施例1	キュペラゾン	ポリリンゴ酸	281	3.5
実施例2	キュペラゾン	ポリアスパラギン酸	234	1.9
実施例3	キュペラゾン	ポリアクリルアミド	187	0.3
実施例4	Lートリプトファン	ポリアクリルアミド	219	0.9
実施例5	Lートリプトファン	ポリアクリル酸アンモニウム	210	0.7
実施例6	Lートリプトファン	ポリリンゴ酸	252	2.2
実施例7	ベンゾトリアゾール	ポリアクリル酸アンモニウム	185	0.2
実施例8	ベンゾトリアゾール	ポリアクリルアミド	196	0.4
実施例9	ナフトトリアゾール	ポリリンゴ酸	203	0.5
実施例10	ナフトトリアゾール	2-メチル-3-ニトロベンジル	212	1.1
		アルコール		÷
実施例11	トリアジンジチオール	ポリアスパラギン酸	186	0.4
実施例12	トリアジンジチオール	ポリアクリルアミド	224	1.0
比較例1	キュペラゾン	(なし)	255	15.3
比較例2	Lートリプトファン	(なし)	287	10.3
比較例3	ベンゾトリアゾール	(なし)	93	2.4
比較例4	ナフトトリアゾール	(なし)	72	2.1
比較例5	トリアジンジチオール	(なし)	98	4.8

実施例13

DLーリンゴ酸(試薬特級) 0. 15重量部に水70重量部を加えて溶解し、これに、BTA0.1重量部をメタノール 0. 8重量部に溶解した溶液を加えた後、さらにポリアクリル酸アンモニウム 0. 025重量部を40%水溶液として加え、最後に過酸化水素水(試薬特級、30%水溶液)33.2重量部を加えて、金属用研磨液を得た。本実施例では、酸化金属溶解剤として水溶性の高い有機酸であるDLーリンゴ酸を用い、第2の保護膜形成剤としては水溶性のポリアクリル酸アンモニウム塩を用いた。

この金属用研磨液を用い、実施例1と同様の条件でCMP実験を行ったところ、CMP速度が287nm/分、エッチング速度も3.6 nm/分といずれも良好であった。ただし、溝パ

ターンが形成された基体については所定の厚さをCMP除去するのに必要なCMP時間よりも50%余計にCMP研磨して電子顕微鏡観察した結果、幅 10μ mの溝部(埋め込み配線となる部分)でのディッシングは約200nmであった。ディッシングを100nm以下に抑制するためには過剰CMP時間を20%にとどめる必要があった。エロージョン及び研磨傷は発生しなかった。

実施例14

DL-リンゴ酸(試薬特級) 0. 15重量部に水70重量部を加えて溶解し、これに、BTA0.2重量部をメタノール0.8重量部に溶解した溶液を加えた後、さらにポリアクリル酸アンモニウム塩0.125重量部を40%水溶液として加え、最後に過酸化水素水(試薬特級、30%水溶液)33.2重量部を加えて、金属用研磨液を得た。本実施例では、酸化金属溶解剤として水溶性の高い有機酸であるDL-リンゴ酸を用いており、第2の保護膜形成剤としては水溶性のポリアクリル酸アンモニウム塩を用いている。

この金属用研磨液を用いて、実施例1と同様の条件でCMP実験を行った。その結果、CMP速度が185nm/分と高く、エッチング速度は0.2nm/分と低い結果を得た。また、実際に溝パターンが形成された基体についても上記CMP条件と同様にしてCMPを施し上述のように観察を行ったところ、過剰CMPを50%相当の時間行ってもディッシングは50nm以下で、エロージョン及び研磨傷は発生しなかった。

実施例15

DLーリンゴ酸の代わりにDLー酒石酸を用いた他は、実施例14と同様にして金属用研磨液を調製し、実施例1と同様にしてCMP実験を行った。その結果、研磨速度は194nm/分と高く、エッチング速度が0.8nm/分であった。また、実施例13と同様の溝パターンが形成された基体をCMPした後、基板を観察したところ、過剰CMP研磨を50%相当の時間を行った場合のディッシングは約70nmで、エロージョン及び研磨傷は発生しなかった。

実施例16

DLーリンゴ酸の代わりにクエン酸を用いた他は、実施例13と同様にして金属用研磨液を調製し、実施例1と同様にしてCMP実験を行った。その結果、CMP速度は213nm/分と高かったが、エッチング速度が 4.6nm/分とやや劣っていた。また、実施例13と同様の溝パターンが形成された基体に30%相当の時間を過剰CMPした後の観察の結果、ディッシングは約150nm以下で、エロージョン及び研磨傷は発生しなかった。

比較例 6

ポリアクリル酸アンモニウムを添加しない他は、実施例13と同様にして金属用研磨液を調製し、実施例1と同様にしてCMP実験を行った。その結果、CMP速度は140nm/分と少し劣る程度であったが、エッチング速度が10.3nm/分と劣っていた。また、実施例13と同様の溝パターンが形成さ

れた基体を、30%相当の時間分過剰にCMP研磨した後、基体表面を観察した結果、ディッシングは約300nmに増加した。エロージョン及び研磨傷は観察されなかった。

比較例7

ポリアクリル酸アンモニウムを用いないことと、ベンゾトリアゾールの添加量を 0.1 重量部から 0.2 重量部に増やしたことの他は、実施例 13と同様にして金属用研磨液を調製し、これを用いて、実施例 1と同様にして CMP 実験を行った。

その結果、エッチング速度は2.4nm/分と良好であったが、CMP速度は93nm/分と劣っていた。また、実施例13と同様の溝パターンが形成された基体に対して30%相当の時間分過剰にCMP研磨を施した後、基体表面を観察した結果、ディッシングは約150nmと十分に満足できる値ではなかった。エッチング速度は低かったがCMP速度も低く、CMPに長時間を要したためと考えられる。エロージョン及びスクラッチは発生しなかった。

これら実施例及び比較例により、第1の保護膜形成剤のみを所定濃度に添加して10nm/分以下のエッチング速度に抑制する効果を、第2の保護膜形成剤を併用することによって、第1の保護膜形成剤がより低濃度であっても達成でき、しかもより高いCMP速度を維持するという効果が発現された。これにより、ディッシング、エロージョンや研磨傷の発生を抑制し、かつ、高いCMP速度で信頼性の高い埋め込みパターンを形成することが可能であることが分かった。

産業上の利用可能性

上述のように、本発明によれば、エッチング速度を十分に低下させ、高いCMP速度を維持し信頼性の高い埋め込みパターンを形成することができる。

請求の範囲

- 1. 酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第1の保護膜形成剤とは異なる第2の保護層形成剤及び水を含有する金属用研磨液。
- 2. 上記第1の保護膜形成剤が、

アンモニア、アミン、アミノ酸、イミン、アゾール、メルカ プタン及び糖類のうちから選ばれた少なくとも1種である、請 求項1記載の金属用研磨液。

3. 上記第1の保護膜形成剤が、

ベンゾトリアゾール及びその誘導体のうちから選ばれた少な くとも1種である請求項2記載の金属用研磨液。

4. 上記第1の保護膜形成剤は、

金属膜表面に物理的吸着及び/又は化学的結合を形成することにより保護膜を形成する化合物である、請求項1記載の金属用研磨液。

5. 上記第2の保護膜形成剤が、

アルコール性又はフェノール性水酸基を有する化合物、エステル、エーテル、多糖類、アミノ酸塩、ポリカルボン酸、ポリカルボン酸、ポリカルボン酸塩、ビニル系ポリマ、アミド、アゾ化合物及びモリブデン化合物である、請求項1記載の金属用研磨液。

6. 上記第2の保護膜形成剤が、

WO 00/13217

ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアミド酸、ポリア クリル酸アンモニウム、ポリメタクリル酸アンモニウム、ポリ アミド酸アンモニウム及びポリアクリルアミドのうちから選ば れた少なくとも1種である請求項5記載の金属用研磨液。

7. 上記第2の保護膜形成剤が、

第1の保護膜形成剤が保護膜を形成するのを補助する化合物である、請求項1記載の金属用研磨液。

8. 上記酸化剤が、

過酸化水素、硝酸、過ヨウ素酸カリウム、次亜塩素酸及びオ ゾン水のうちから選ばれた少なくとも1種である請求項1記載 の金属用研磨液。

9. 上記酸化金属溶解剤が、

有機酸、有機酸のアンモニウム塩及び硫酸のうちから選ばれた少なくとも1種である請求項1記載の金属用研磨液。

10. 上記酸化金属溶解剤が、

リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸アンモニウム、酒石酸アンモニウム及びクエン酸アンモニウムのうちから選ばれた少なくとも1種である請求項9記載の金属用研磨液。

11. 化学機械研磨速度が100nm/分以上、 エッチング速度が10nm/分以下である金属用研磨液。

- 12. 上記エッチング速度が1nm/分以下である、請求項1 1記載の金属用研磨液。
- 13. 上記化学機械研磨速度が250 nm/分以上である、請求項11記載の金属用研磨液。
- 14.酸化剤、酸化金属溶解剤、第1の保護膜形成剤、第1の保護膜形成剤とは異なる第2の保護層形成剤及び水を含有する請求項11~13のいずれかに記載の金属用研磨液。
- 15. 金属膜表面に物理的吸着及び/又は化学的結合を形成することにより保護膜を形成する化合物である第1の保護膜形成 剤と、

第1の保護膜形成剤が保護膜を形成するのを補助する化合物である第2の保護膜形成剤とを含む金属用研磨液。

- 16. 銅、銅合金、銅酸化物、及び、銅合金酸化物のうちの少なくともいずれかを含む金属を研磨するための、請求項1、11又は15記載の金属用研磨液。
- 17. 実質的に砥粒を含まない、請求項1、11又は15記載の金属用研磨液。
- 18. 上記第2の保護膜形成剤は、 エッチング速度を10nm/分以下に抑制するのに必要な第

- 1 の保護膜形成剤の添加量を減少させる化合物である請求項 1 記載の金属用研磨剤。
- 19. 請求項1、11又は15記載の金属用研磨液中で被研磨物表面の金属膜を研磨することにより除去する研磨方法。
- 20. 上記金属膜は、
- 銅、銅合金、銅酸化物、及び、銅合金酸化物のうちの少なく ともいずれかを含む請求項19記載の研磨方法。
- 21. 上記被研磨物は、

表面に、銅、銅合金、銅酸化物、及び、銅合金酸化物のうちの少なくともいずれかを含む金属層を備える積層膜を備え、

上記研磨方法は、

上記積層膜から、上記金属層の少なくとも一部を除去する方法である、請求項19記載の研磨方法。

22. 上記金属用研磨液が実質的に砥粒を含まない、請求項19記載の研磨方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04694

A. CLASSI	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁶ H01L21/304, 21/308, C23F1/1	.6				
	International Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC				
B. FIELDS	cumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)				
Int.	Cl ⁶ H01L21/304, 21/308, C23F1/1	16				
Documentati	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included i	n the fields searched			
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)			
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y	US, 5954997, A (CABOT CORP.),		1-22			
	09 December, 1996 (09.12.96) & JP, 11-21546, A & EP, 84674	.2 22				
	& WO, 98/26025, A1	,				
Y	JP, 8-83780, A (TOSHIBA CORPORA	TION),	1-22			
	26 March, 1996 (26.03.96),					
	Claims & US, 5770095, A					
		ATTON\	1-22			
A	<pre>JP, 7-233485, A (TOSHIBA CORPOR 05 September, 1995 (05.09.95),</pre>	ATION),	1			
	Claims (Family: none)					
A	JP, 9-55363, A (TOSHIBA CORPORA 25 February, 1997 (25.02.97),	ATION),	1-22			
	Claims (Family: none)					
A	JP, 9-184081, A (Nippon Peroxid	le Co., Ltd.),	1-22			
1	15 July, 1997 (15.07.97),					
	Claims (Family: none)	□ C				
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	emational filing data or			
"A" docum	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with the	he application but cited to			
"E" earlier	ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
date "L" docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered step when the document is taken along "Y" document of particular relevance; the	e			
special	o establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	considered to involve an inventive ste	p when the document is			
means						
than th	ent published prior to the international filing date but later to priority date claimed	"&" document member of the same patent	<u> </u>			
Date of the 22 1	actual completion of the international search November, 1999 (22.11.99)	Date of mailing of the international sea 07 December, 1999 (rch report 07.12.99)			
Name and n	nailing address of the ISA/	Authorized officer				
Japa	Japanese Patent Office					
Facsimile N	lo.	Telephone No.				

		У
		.t.
		•
		*

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁶ H01L21/304, 21/308, C23F1/16

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁶ H01L21/304, 21/308, C23F1/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	ると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	US, 5954997, A (CABOT CORP.) 9. 12 月. 1996 (09. 12. 96) & JP, 11-21546, A &EP, 846742, A2&WO, 98/26025, A1	1-22
Y	JP, 8-83780, A (株式会社東芝) 26.3月.199 6 (26.03.96) 特許請求の範囲&US, 5770095, A	1 – 2 2
A	JP, 7-233485, A (株式会社東芝) 5. 9月. 199 5 (05. 09. 95) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-22

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

G ((#.))	EDINA N. A.	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	用・古・ナッ
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 9-55363, A (株式会社東芝) 25. 2月. 1997 (25. 02. 97) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	$1 - 2 \ 2$
A	JP, 9-184081, A (日本パーオキサイド株式会社) 15.7月.1997 (15.07.97) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-22
	·	

PCT

E P US

国際調査報告

(法3条、法施行規則第40、41条) (上1718条、PCT規則43、44)

出願人又は代理人 の書類記号 HC1467	701	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP99/0469	9 4	国際出願日(日.月.年)	31.08	3. 99	優先日(日.月.年)	31.08.98
出願人 (氏名又は名称) 日立	2化成工第	类株式会社				
		 				
国際調査機関が作成したこのこの写しは国際事務局にも説			測第41条	(PCT18\$	条) の規定に従い	ハ出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で	ق 3	ページである) o		·	•
□ この調査報告に引用され	た先行打	を術文献の写しも	添付されて	こいる。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場 この国際調査機関						すった。
b. この国際出願は、ヌク この国際出願に含			列を含んて	おり、次の配	記列表に基づき国	国際調査を行った。
□ この国際出願と共	に提出さ:	れたフレキシブル	ルディスク	による配列表		
□出願後に、この国	際調査機	関に提出された	書面による	配列表		
□出願後に、この国						:
□ 出願後に提出した ³ 書の提出があった。		る配列表が出願明	時における	国際出願の開	示の範囲を超え	る事項を含まない旨の陳述
	- に記載し	た配列とフレキシ	シブルディ	スクによる配	列表に記録した	配列が同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部	『の調査が	ゞできない(第I	欄参照)。			
3. 🗌 発明の単一性が欠	さ如してい	ヽる(第Ⅱ欄参照	1) .			
4. 発明の名称は	区 出願	頁人が提出したも	のを承認す	⁻る。		
	□ 次に	ニ示すように国際	調査機関が	作成した。		
5. 要約は	区 出願	質人が提出したも	のを承認す			
	国際		した。出解	(人は、この)	国際調査報告の第	見則38.2(b)) の規定により を送の日から1カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表され 第 図とする。		負人が示したとお	sりである。		区 な	し .
	□ 出解	重人は図を示さな	かった。			
	□ 本図	団は発明の特徴を	一層よく表	そしている。		

.

والمراجعة المتأكلة والمنطقة المنكولة والمراجعة والمراجع والمراجع والمناجعة والمستعين يباريها والمراجع

Α.	発明の属す	る分野の分類	(国際特許分類	(I	PC))
----	-------	--------	---------	----	-----	---

Int. Cl⁶ H01L21/304, 21/308, C23F1/16

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁶ H01L21/304, 21/308, C23F1/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

	. 2 10 17 74 0 74 10 1				
引用文献の		関連する			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号			
Y	US, 5954997, A (CABOT CORP.) 9. 12 月. 1996 (09. 12. 96) & JP, 11-21546, A &EP, 846742, A2&WO, 98/26025, A1	1-22			
Y	JP, 8-83780, A (株式会社東芝) 26.3月.1996 (26.03.96) 特許請求の範囲&US, 5770095, A	1-22			
A	JP, 7-233485, A (株式会社東芝) 5.9月.199 5 (05.09.95) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-22			

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 22.11.99 国際調査報告の発送日 22.11.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3P 8916 日本国特許庁(ISA/JP) 鈴木 充 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3363

(((()))		映番方	PCT/JP	99/04694
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関	関連する	・ 簡所の表示	関連する
A	JP, 9-55363, A (株式会社東芝) 2 7 (25.02.97) 特許請求の範囲 (ファミ	5. 2	2月. 199	請求の範囲の番号
_	・ (20.02.97) 特計請求の範囲 (ファミ	リーな	こし)	
Α	JP, 9-184081, A (日本パーオキサ 5.7月.1997 (15.07.97) 特許請求 リーなし)	イド棋	式会社) 1	1-22
	リーなし)	水の軍	強囲(ファミ	
			-	
	•		•	
			•	
	en e			
	· -			
				`
				1
,				
	•			